

SPECIFICATION TRANSISTORS, DIODES.

NO. 17 - 2T-1323

2 S C 1 4 7 5

PAGE: 2/20/73

暫 定



DATE: / /

1. 構造 NPN・APM形・エピタキシャル・シリコン・トランジスタ
2. 用途 低周波～高周波電力増巾，スイッチング
3. 外形 付図参照
4. 絶対最大定格 (Ta=25°C)

*GAIN GROUPS -
2, 3, 4 w own
option
10K w, 20
30 Days from
D.O.A.*

| | | |
|--------------|------------------|--------------|
| コレクタ・ベース間電圧 | V _{CBO} | 100V |
| コレクタ・エミッタ間電圧 | V _{CEO} | 50V |
| エミッタ・ベース間電圧 | V _{EBO} | 6V |
| コレクタ電流 | I _C | 1A |
| ベース電流 | I _B | 0.5A |
| コレクタ損失 | P _C | 750mW |
| ジャンクション温度 | T _j | 150°C |
| 保存温度 | T _{stg} | -50°C~+150°C |

5. 電気的特性 (Ta=25°C)

| 項目 | 記号 | 条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---------------|-----------------------|--|-----|-----|------|------|
| コレクタ遮断電流 | I _{CBO} | V _{CB} =25V, I _E =0 | | | 0.2 | μA |
| エミッタ遮断電流 | I _{EBO} | V _{EB} =6V, I _C =0 | | | 0.2 | μA |
| ベース・エミッタ電圧 | V _{BE} | V _{CE} =6V, I _C =5mA | | | 0.70 | V |
| コレクタ・エミッタ電圧 | V _{CEO(sus)} | I _C =2mA | 50 | | | V |
| コレクタ・エミッタ飽和電圧 | V _{CE(sat)} | I _C =1A, I _B =50mA | | | 0.3 | V |
| ベース・エミッタ飽和電圧 | V _{BE(sat)} | | | | 1.0 | V |
| 直流電流増巾率 | h _{FE1} | V _{CE} =2V, I _C =100mA | 98 | | 649 | |
| 直流電流増巾率 | h _{FE2} | V _{CE} =1V, I _C =1A | 70 | | | |
| 小信号電流増巾率 | h _{fe} | V _{CB} =2V, I _E =10mA, f=10MHz | | 18 | | dB |
| コレクタ出力容量 | C _C | V _{CB} =10V, I _E =0A, f=1MHz | | 16 | 40 | pF |
| 熱抵抗 | θ _{j-a} | | | | 126 | °C/W |

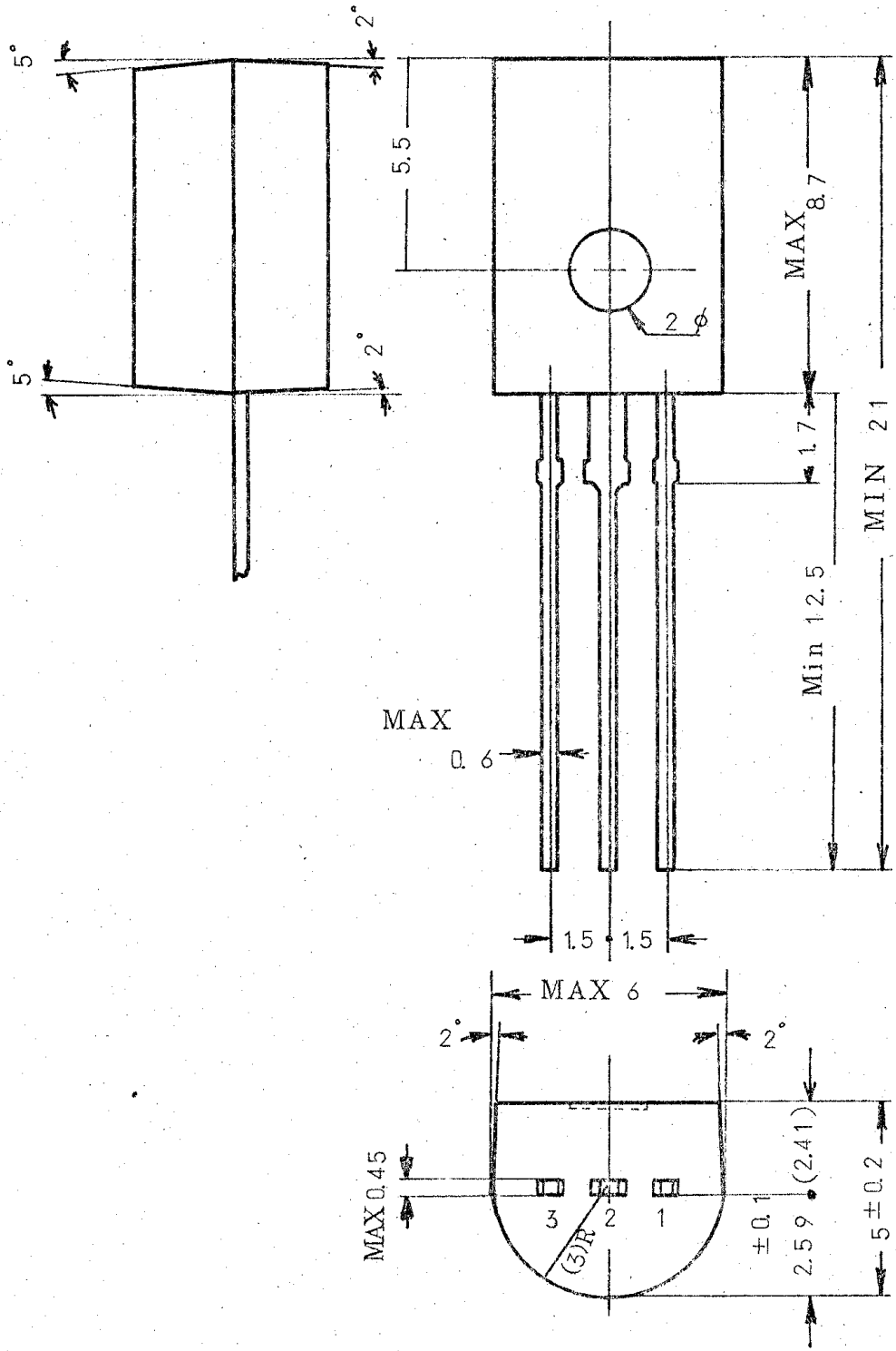
DATE

TOSEI CO. INC

NAME

6. 規格細分

| | $h_{FE1} (V_{CE}=2V, I_C=100mA)$ | |
|---|----------------------------------|-----|
| | 最小値 | 最大値 |
| 1 | 98 | 156 |
| 2 | 140 | 222 |
| 3 | 199 | 316 |
| 4 | 285 | 451 |
| 5 | 409 | 649 |



- 1 ベース
- 2 コレクタ
- 3 エミッタ

{ 1/1 }